

반도체 Ptfе 세정 바스켓 12인치 웨이퍼 습식 에칭 랙 내산알칼리 불소중합체 캐리어

품목 번호: PL-CP81



소개

고순도 반도체 환경에 맞춰 설계된 이 12인치 PTFE 웨이퍼 세정 바스켓은 핵심 습식 에칭 및 세정 공정에서 탁월한 내화학성을 보장합니다. 맞춤 제작된 설계는 정밀 제조를 위해 안정적인 웨이퍼 지지력과 최대 유체 노출을 제공합니다.

자세히 알아보기

적용 분야	설명	주요 이점
RCA 세정	유기 오염물과 금속 불순물을 제거하기 위한 표준화된 시퀀스(SC-1 및 SC-2).	고pH 및 저pH 전이 과정에서 재오염을 방지합니다.
HF 에칭	불산 용액을 사용하여 희생 산화물 층 또는 자연 산화물을 제거.	HF 공격에 대한 완전한 내성으로 장기간 장비 수명을 보장합니다.
피라냐 에칭	포토레지스트 제거를 위해 황산과 과산화수소를 고온에서 혼합.	구조적 연화 없이 극심한 발열 반응을 견딥니다.
CMP 후 린싱	화학적 기계적 연마 후 슬러리 입자와 화학 물질을 제거.	최소 접점이 웨이퍼 뒤에서 입자 간섭을 방지합니다.
태양 전지 텍스처링	광 흡수를 개선하기 위해 대형 실리콘 웨이퍼를 산 또는 알칼리로 텍스처링.	지속적인 화학 노출 환경에서 고용량 내구성을 제공합니다.
MEMS 제조	미세기계 구조물을 만들기 위해 실리콘 또는 유리 기판을 습식 에칭.	최적화된 유체 순환을 통해 균일한 에칭 속도를 보장합니다.
포토리소그래피	특수 유기 용매를 사용하여 포토레지스트 재료를 현상 및 스트리핑.	내용매성 재료가 현상액에 유기물이 용출되는 것을 방지합니다.
메가소닉 세정	웨이퍼 표면에서 서브미크론 입자를 제거하기 위한 고주파 음향 세정.	재료 밀도가 감소 효과 없이 음향 에너지를 효과적으로 전달합니다.

특징	사양 세부 정보(PL-CP81)
주요 재료	고순도 버진 PTFE(폴리테트라플루오로에틸렌)
웨이퍼 직경 호환성	300mm(12인치) - 요청 시 맞춤 사이즈 제공 가능
구성	단일 웨이퍼 캐리어 / 다중 웨이퍼 플라워 바스켓 구성
제조 공정	정밀 CNC 가공 / 맞춤 제작
내화학성	전 범위(pH 0-14): HF, HNO3, HCl, H2SO4, KOH 등에 내성
작동 온도	최대 260°C까지 연속 사용 (설계에 따라 맞춤 제한 가능)
슬롯 피치 / 간격	유체 유동 또는 용량 요구 사항을 충족하기 위해 완전히 맞춤 설정 가능
접점 유형	점접촉 또는 가장자리접촉 설계 제공 가능
핸들 옵션	고정식, 탈착식 또는 자동화 로봇 플랜지 인터페이스
표면 조도	입자 부착을 최소화하기 위한 초평활 가공 마감
순도 기준	반도체 등급 적합; 미량 금속 분석 제공 가능